ABSTRACT

A light-emitting diode 1 according to the present invention includes: a semiconductor light-emitting device 4 mounted on the surface of lead frames 2 and 3; and a transparent resin package 5 covering the front side of the semiconductor light-emitting device 4. A convex lens portion 8 for concentrating light emitted from the semiconductor light-emitting device 4 toward the front is provided in a surface part of the resin package 5. A circular flat portion 11 for diffusing light emitted from the semiconductor light-emitting device 4 toward the sides is provided in a part of the convex lens portion 8 intersecting the optical axis of the convex lens portion 8. Part of the convex lens portion 8 surrounding the circular flat portion 11 is a convex-lens side face. A recess 7 whose side wall is partly the convex-lens side face is provided to surround the convex lens portion.

10



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年5 月21 日 (21.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/042833 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 33/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014048

(22) 国際出願日:

2003年11月4日(04.11.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

Љ 特願2002-320889 2002年11月5日(05.11.2002) ЛЪ 2003 年8 月5 日 (05.08.2003) 特願2003-286672 JP 2003年8月5日(05.08.2003) 特願2003-286673 2003年8月20日(20.08.2003) Ъ 特願2003-296065 特願2003-299590 2003 年8 月25 日 (25.08.2003) Ъ 2003年9月1日(01.09.2003) Ъ 特願2003-308564 特願2003-308563 2003 年9 月1 日 (01.09.2003) Ъ (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真 1006番地 Osaka (JP).

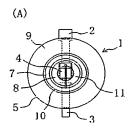
(72) 発明者; および

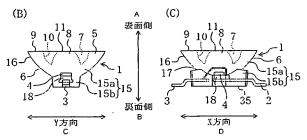
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 池田 忠昭 (IKEDA,Tadaaki) [JP/JP]; 〒899-2503 庭児島県 日置 郡伊集院町 妙円寺 1-7 3-1 6 Kagoshima (JP). 徳富眞治 (TOKUTOMI,Shinji) [JP/JP]; 〒899-2503 庭児島県 日置郡伊集院町 妙円寺 1-1 1 1-4 Kagoshima (JP). 古閑 憲昭 (KOGA,Noriaki) [JP/JP]; 〒890-0003 庭児島県 庭児島市伊敷町 3108-2-401 Kagoshima (JP).
- (74) 代理人: 前田 弘 , 外(MAEDA, Hiroshi et al.); 〒550-0004 大阪府 大阪市 西区靱本町 1 丁目 4番 8号 本町 中島ビル Osaka (JP).

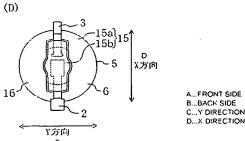
[続葉有]

(54) Title: LIGHT-EMITTING DIODE

(54) 発明の名称: 発光ダイオード







(57) Abstract: A light-emitting diode (1) comprises a semiconductor light-emitting device (4) mounted on the front surfaces of lead frames (2, 3) and a light-transmitting resin package (5) covering the front side of the semiconductor light-emitting device (4). A front side portion of the resin package (5) is provided with a convex lens portion (8) for focusing lights emitted from the semiconductor light-emitting device (4) to the front side. A portion of the convex lens (8) which intersects with the optical axis of the convex lens (8) is formed as a circular plane portion (11) for spreading lights emitted from the semiconductor light-emitting device (4) to lateral directions. The lateral portion of the convex lens (8) surrounds the periphery of the circular plane portion (11), and a concave portion (7) is provided so as to surround the side of the convex lens. The lateral portion of the convex lens serves as a part of the side wall of the concave portion (7).

(57) 要約: 本発明の発光ダイオード1は、リードフレーム2,3の表面上に搭載された半導体発光素子4と、半導体発光素子4の表側を覆う光透過性の樹脂パッケージ5とを備えている。樹脂パッケージ5の表面部には、半導体発光素子4から出射された光を表側に集光する凸レンズ部8が設けられ、凸レンズ部8のうち凸レンズ部8の光軸と交差する部分には、半導体発光素子4から出射された光を側方に拡げる円状平面部11が設けられている。凸レンズ側面部であって、凸レンズの側方を囲む部分には、凸レンズ側面部を側壁の一部とする凹部7が設けられている。



- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ

パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。